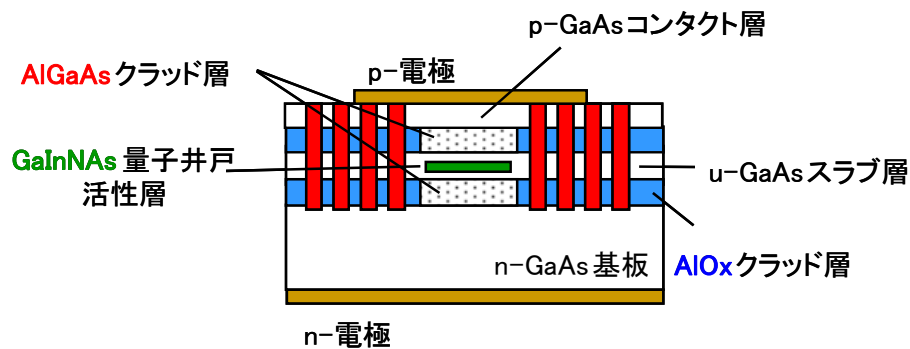
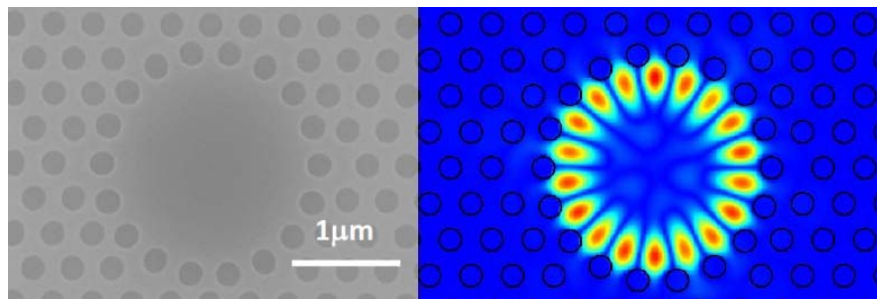


研究テーマ

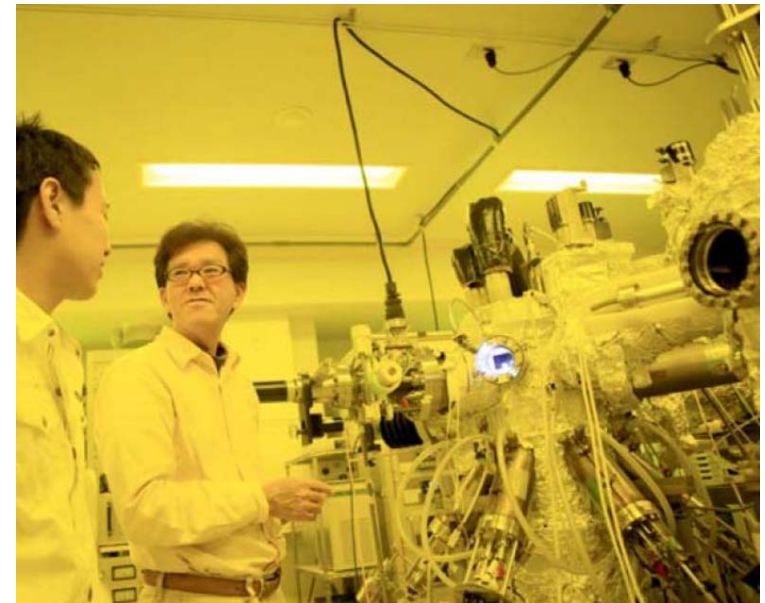
次世代IT社会を拓く革新的な半導体デバイスの研究開発

主研究内容

円形欠陥(CirD)フォトリック結晶半導体レーザー ~第3の基本構造を目指して~



開発するレーザーの構造（俯瞰図および断面図）



新半導体材料 GaInNAs が結晶成長できる分子線エピタキシー (MBE) 装置

スタッフ

教授： 近藤 正彦

准教授： 梶井 博武

助教： 森藤 正人